製品概要

MBRS2H100T3G: ショットキー・ パワー・ レクティファイヤ、表面実装、2.0 A、100 V

技術情報は、データシートをご参照ください。

このショットキー・ レクティファイヤは、大面積の金属 - シリコン接合のパワーダイオードでショットキー・ バリア原理を採用しています。これは、酸化物不動態化のエピタキシャル構造および金属オーバーレイ・ コンタクトを備えています。低電圧で高周波のスイッチング電源、フリーホイール・ ダイオード、極性保護ダイオードに最適です。

特長

- Compact Package with J-Bend Leads Ideal for Automated Handling
- Highly Stable Oxide Passivated Junction
- Guard-Ring for Overvoltage Protection
- Low Forward Voltage Drop
- This is a Pb-Free Device Mechanical Characteristics:
- Case: Molded Epoxy
- Epoxy Meets UL 94 V-0 @ 0.125 in
- Weight: 70 mg (approximately)
- Cathode Polarity Band
- Lead and Mounting Surface Temperature for Soldering Purposes: 260C Max. for 10 Seconds

For more features, see the data sheet

利点

- Low Power Loss / High Efficeincy

アプリケーション

- Power Supplies
- Free Wheeling Diodes
- Polarity Protection Diodes

最終製品

- LED Lamps

電気的仕様

製品	Pricing ($/Unit)	Compliance	Status	Configuration	V_{RRM} Min (V)	V_F Max (V)	I_{RM} Max (µA)	$I_{O(rec)}$ Max (A)	I_{FSM} Max (A)	t_{rr} Max (ns)	C_j Max (pF)	Package Type
MBRS2H100T3G	0.1491	Pb-free Halide free non AEC-Q and PPAP	Active	Single	100	0.79	8	2	130	-	-	SMB-2

詳細は、弊社 www.onsemi.jp の営業または販売代理店にお問い合わせください。

6/2/2021 作成